



⑯ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 101 59 702 A 1

⑯ Int. Cl.⁷:
H 01 L 21/68

DE 101 59 702 A 1

⑯ Aktenzeichen: 101 59 702.9
⑯ Anmeldetag: 5. 12. 2001
⑯ Offenlegungstag: 18. 7. 2002

⑯ Innere Priorität:
100 64 943. 2 23. 12. 2000

⑯ Erfinder:
Strzyzewski, Piotr, 52134 Herzogenrath, DE

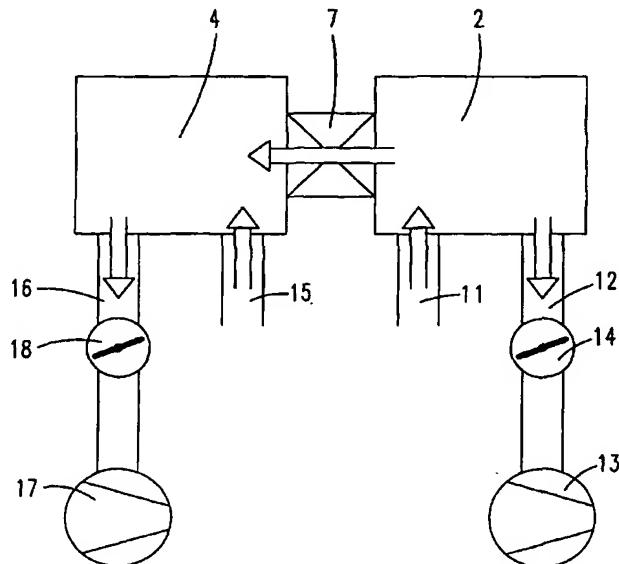
⑯ Anmelder:
Aixtron AG, 52072 Aachen, DE

⑯ Vertreter:
H.-J. Rieder und Kollegen, 42329 Wuppertal

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑯ Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung von Halbleitersubstraten

⑯ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bearbeitung von Halbleitersubstraten, wobei die insbesondere unbeschichteten Halbleitersubstrate durch eine Beladungsschleuse (1) einer Bearbeitungsanordnung zugeführt werden, welche Beladungsschleuse (1) an eine Transferkammer (2) angrenzt, von welcher wiederum eine Vielzahl von Bearbeitungskammern (3, 4, 5) mit den zu bearbeitenden Halbleitersubstraten beladbar sind, wozu zunächst die Transferkammer (2) und die Bearbeitungskammer (3) evakuiert werden und daran anschließend eine Verbindungstür (7) zwischen Transferkammer (2) und Bearbeitungskammer (3) geöffnet wird. Als Verbesserung schlägt die Erfindung vor, dass mindestens einer der Bearbeitungskammern (4) ein Niedrigdruck- oder Atmosphärendruck-Prozess betrieben wird und vor dem Öffnen der dieser Bearbeitungskammer (4) zugeordneten Verbindungstür (8) die Transferkammer (2) mit einem Inertgas geflutet wird, wobei zwischen Transferkammer und Bearbeitungskammer eine vorbestimmte Druckdifferenz erhalten bleibt.



DE 101 59 702 A 1